

	Re-SiC-ještě n ení skladem	N-SiC	O-SiC
Max. Teplota použití (°C)	1600	1550	1370-1450
Chemické složení (%)			
SiC	99	75%	90
Si	0	0	0
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	0	22	0
SiO <sub>2</sub>	0	0	8
Porosita (%)	15	<16	7-8
Hustota (g/cm <sup>3</sup> )	2.6 – 2.74	>2.65	2.75
Odolnost vůči křehkému lomu (Modulus of Rupture) (MPa)			
Za pokojové teploty	900	>170	50
Za 1200°C			
Za 1400°C	100	>50	55
Teplotní roztažnost za 1000°C (K <sup>-1</sup> )	4.8*10 <sup>-6</sup>	<4.18	4.2-4.8*10 <sup>-6</sup>
Tepelná vodivost za 1000°C (W/m.K)	25	>16	13.5-14.5